

半导体学报

第 10 卷 第 11 期 1989 年 11 月

目 录

- GaAs/AlGaAs 量子阱中的 Γ -X 混和及谐振态和非限定态的研究 ... 薛舫时 (805)
- 双离子注入短沟道 MOS-FET 的阈值电压解析模型 汤庭鳌 陈登元 Carlos Araujo (812)
- MIS 隧道器件电流-电压特性的数值模拟 夏永伟 G. Pananakakis and G. Kamarinos (822)
- 群法及其在 LSI/VLSI 自动布图设计中的应用 俞明永 马佐成 庄文君 (833)
- 定域 SOI 区熔再结晶研究 柳连俊 钱佩信 张宗铭 潘子康 李志坚 (840)
- 离子束混合诱导烯土金属 Ce 与 Si 的界面反应及硅化物的形成 杨熙宏 毛思宁 陈 坚 刘家瑞 杨 锋 许天冰 (846)
- ✓ 硅中离子注入硼的异常扩散 郭 强 鲍希茂 严 勇 冯 端 (853)
- 等离子增强化学汽相淀积 a-SiC:H 薄膜的 AES 研究 刘德中 罗兴华 张 伟 王季陶 (859)
- CoMnNi 氧化物非晶薄膜退火研究 谭 辉 陶明德 韩 英 (865)
- SnO₂ 薄膜的红外光谱和表面光电电压谱的研究 戴国瑞 姜月顺 王雅静 董玺娟 汤大新 李铁津 (871)
- 研 究 简 报**
- 难熔金属硅化物的喇曼散射 陈存礼 曹明珠 何胜龙 徐伟文 蒋宏伟 茅保华 (878)
- GaAs/GaAlAs 多量子阱激子吸收谱 曾 安 吴荣汉 曾一平 孔梅影 王启明 (881)